预习 操作记录	实验报告 总评成绩					

《大学物理实验》课程实验报告

专业: 实验人姓名: 学号:

参加人姓名:

日期: 年月日 室温: 相对湿度:

实验 12 塞曼效应实验

[实验前思考题]

1. 什么是塞曼效应?

2. 如何观测塞曼效应?

[实验目的]

- 1. 学习观察塞曼效应的实验方法。
- 2. 计算电子的荷质比e/m。

[仪器用具]



一、塞曼效应简介

1896年,塞曼发现,当光源放在足够强的磁场中,所发出的谱线会产生分裂,分裂的谱线数量与原子能级有关,并且所发出的谱线都是偏振的,这种现象叫做塞曼效应。它揭示了原子内部运动的量子效应,到目前为止,塞曼效应仍然是研究原子内部结构的一种重要方法。

BEX-8501塞曼效应实验装置主要用于近代物理实验教学。用于验证磁场对光源的影响,以及提供一种精确计算电子荷质比的方法。

二、实验原理

1. 基本原理

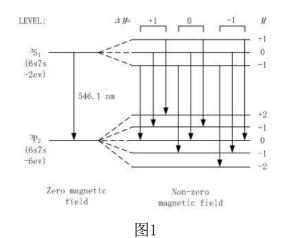
当发光原子置于磁场中,它所发出谱线将分裂成几条谱线。这种现象叫做塞曼效应。塞曼在1986年首次发现这个现象,并于1902年因此获得诺贝尔物理学奖。原子中的电子由于作轨道运动产生轨道磁矩,电子同时还具有自旋运动产生自旋磁矩。轨道角动量和自旋角动量合成原子的总角动量,轨道磁矩和自旋磁矩合成原子的总磁矩。在外磁场中,原子的总磁矩在外磁场中受到力矩的作用,而力矩使原子的总角动量绕磁场方向作进动,进动引起附加的能量,而这个附加能量和磁量子数M有关。这样,无外磁场时的一个能级,在外磁场的作用下就分裂成2.升1个能级。但是电子并非能在任何两个能级间跃迁,必须满足选择定则: 4 M=0 或者 ±1

- (1) 当 ΔM 时,在垂直于磁场的方向观察时,能观察到线偏振光,线偏振光的振动方向平行于磁场,称为 π 成分。当平行于磁场方向观察时, π 成分不出现。
- (2) 当 ΔM ±1 时,垂直于磁场的方向观察时,能观察到线偏振光,线偏振光的振动方向平行于磁场,称为 σ 成分。当平行于磁场方向观察时,能观察到圆偏振光,圆偏振光的转向依赖于 ΔM 的正负、磁场方向以及观察者相对于磁场的方向。当 ΔM 1,磁场指向观察者时,偏振转向是沿磁场方向前进的螺旋转动,方向为左旋圆偏振光 σ^+ ; 当 ΔM =1,磁场指向观察者时,偏振转向是沿磁场方向倒退的螺旋转动方向,为右旋圆偏振光 σ^- 。

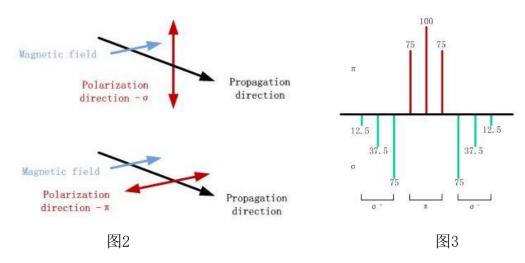
在本实验装置中,是观测汞灯所发出绿线,波长为546.1nm。在足够强的磁场中,它将分裂成9条谱线,如图1所示。不同观察方式和偏振特性如表1所示。

表1

ΔΜ	垂直于磁场	平行于磁场				
+1	线偏振光 σ+	圆偏振光 σ+				
0	线偏振光 π	无光				
-1	线偏振光 σ-	圆偏振光 σ-				



当垂直于磁场方向观察时,可以观测到9条谱线,包括3条 π 偏振谱线,6条 σ 偏振谱线 (如图2所示)。如图3所示,3条 π 线最亮,6条 σ 较弱,可以通过旋转偏振器来观测 π 线和 σ 线。



2. 测量原理

标准具两块镜片的内表面距离为d,中间为空气,折射率为1,光线的入射角为 θ ,则两条光线的光程差为:

$$\Delta = 2d\cos\theta$$

构成干涉极大值的条件是光程差为波长的整数倍,则:

$$\Delta = 2d\cos\theta = k\lambda$$

在标准具中心附近,由于入射角很小,可以认为 $\theta \approx 0$,则 $cos\theta = 1$.由于 $cos\theta$ 随着入射角的增加而减小,所以干涉圆环的最内层级数最高,为K级,依次为K - 1 ,K - 2等等。

从标准具出射的平行光,被焦距为f相机镜头聚焦成像在CMOS相机。如图4所示,干涉圆环的直径D=2f. $tan\theta$,又因为内层干涉圆环的出射角度很小,所以 $\theta=D/2f$,通过二项式展

开,可得第K级圆环满足式(1):

$$2d(1 - D_k^2 / 8f^2) = k\lambda$$
 (1)

电子从高能级跃迁到低能级,所发出的光子频率和能级满足如下关系:

$$h\nu = E_2 - E_1$$

假如存在一个外磁场,则轨道的附加能量为:

$$\Delta E = Mg \cdot (eh/4\pi m) \cdot B \tag{2}$$

其中,e和m分别为电子的电量和质量,h为普朗克常量,M为磁量子数,g为朗德因子。

在外磁场的作用下,上下两能级各获得附加能量 ΔE_1 和 ΔE_2 ,因此每个能级各分裂成 $2J_2+1$ 和 $2J_1+1$ 个子能级,这样上下能级之间的跃迁,将发出频率为v'的谱线,则有:

$$hv' = (E_2 + \Delta E_2) - (E_1 + \Delta E_1)$$

所以分裂的后的谱线与原谱线的频率差为:

$$\Delta v = v - v' = (1/h)(\Delta E_1 - \Delta E_2)$$

将式(2)代入,并用转化为波长表示:

$$\Delta \lambda = (-\lambda^2/c)\Delta v = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \cdot (\lambda^2/4\pi c) \cdot (e/m) \cdot B$$
 (3)

对于K级的不同波长满足如下式(4):

$$\Delta \lambda = \lambda_{k1} - \lambda_k = (D_{(k)}^2 - D_{(k)1}^2) \cdot (d/4f^2k) \tag{4}$$

由能级分裂所产生的谱线的波长差是和相机镜头焦距无关的量,为消去焦距f,由式 (1) 可得K-I级满足如下关系式:

$$2d(1 - D_{(k-1)}^2 / 8f^2) = (k-1)\lambda$$
 (5)

由式(1)和式(5)可得:

$$d/[4f^{2}(D_{(k-1)}^{2}-D_{(k)}^{2})] = \lambda$$
 (6)

由式 (6) 求出 产并代入式 (4):

$$\Delta \lambda = (\lambda/k) \cdot (D_{(k)}^2 - D_{(k)1}^2) / (D_{(k-1)}^2 - D_{(k)}^2)$$
 (7)

由于入射角很小, 所以 $\cos \theta \approx 1$, $k \approx 2d/\lambda$. 代入式 (7) 则:

$$\Delta \lambda = (\lambda^2 / 2d) \cdot (D_{(k)}^2 - D_{(k)1}^2) / (D_{(k-1)}^2 - D_{(k)}^2)$$
 (8)

由式(3)和式(8)可得:

$$e/m = (2\pi c/dB) \cdot [1/(M_2g_2 - M_1g_1)] \cdot (D_{(k)}^2 - D_{(k)1}^2)/(D_{(k-1)}^2 - D_{(K)}^2)$$
(9)

磁量子数和朗德因子关系如表2所示。

表2 磁量子数和朗德因子关系

M					2	1	0	-1	-2		
M_2g_2	$M_{\alpha}g_{\alpha}$					2	0	-2			
³ P ₂	M_1g_1				3	3/2	0	-3/2	-3		
$\Delta = M_2 g_2 - M_1 g_1$		π				1/2	0	-1/2			
		σ	-1	-3/2	-2				2	3/2	1

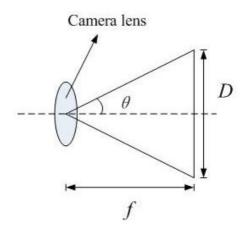


图4-34-4相机镜头出的光路图

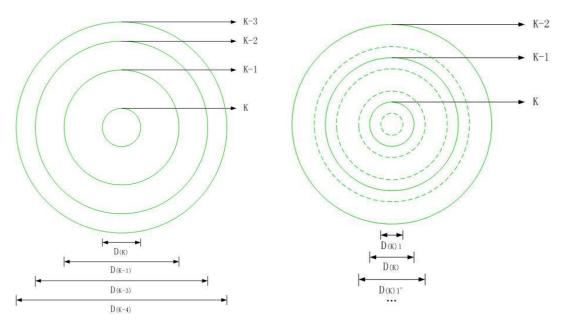


图5磁场为零时的干涉图像

图6磁场足够强时干涉圆环分裂图像

三、仪器安装

- 1. 选择一个大小至少为1.2 m×0.75 m的光学平台或者是实验桌,用于放置该装置和计算机
- 2. 将聚光透镜和偏振器装入具有一维横向调节架的精密调整架中,并旋紧螺钉,锁死,如图7所示。
- 3. 将干涉滤光器旋进法布里泊罗标准具中,如图8所示。图9所示为装了干涉滤光片的标准具。
- 4. 将标准具对着汞灯,从标准具中可以看见一组同心干涉圆环,将眼睛从标准具的中心沿着其中一颗调节螺钉移动,如果干涉圆环也跟着变化,说明标准具的两面镜片的内表面没有平行。假如干涉圆环随着眼睛移动是扩张的,说明调节螺钉太松,需要拧紧,如果干涉圆环是随着眼睛移动是缩小的,说明调节螺钉太紧,需要旋松一些。按此方法,调节另外两颗调节螺钉,把标准具两面镜片的内表面调节平行。



- 5. 当标准具调节完毕,如图10所示,将其装入精密调整架中,并锁死。
- 6. 将焦距为50mm的相机镜头装入CMOS相机,如图11所示。





图10 图 11

- 7. 将所有的杆装入升降调节架,并将升降调节架装在托板上,再将精密调整架和CMOS相机装在杆上,如图12所示。
- 8. 用连接件把导轨和电磁线圈连接,0刻度一端与连接件相连,如图13所示。







图12



图13

9. 参数设定

电磁线圈参数:

- 电阻: <6Ω
- 最大输出电流: 6A
- 最大磁感应强度: ~1.2T

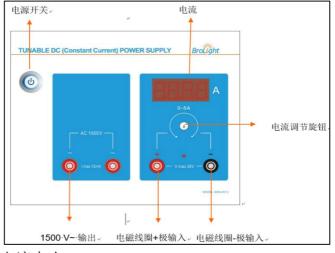
恒流电源参数:

- 输出电流: 0-6A
- 稳定性: ≤0.1%
- 电流表:显示输入电磁场的电流大小
- 电流调节旋钮:设置输入电磁线圈的电流大小
- 电源开关: 开启或者关闭该横流源

10. 连接线和导线

- 用红色和黑色连接好恒流源和电磁线圈。
- 用 USB 数据线连接 CMOS 相机和计算机。

注意: 先断开电源,再连接电源线,连接线等。输入电源可以是 115VAC 或 230VAC. 默认输入电压 230V.



四、实验

1. 垂直于磁场方向

- 如图 14 所示,将汞灯插入电磁线圈中间,电磁线圈可以旋转 90 度。汞灯所发出的 光经透镜聚光后,穿过偏振器,经干涉滤光器滤光后,剩下波长为 546.1nm 的光线,进入 法布里泊罗标准具,形成干涉圆环,经相机镜头和 CMOS 相机成像。(注意:为避免杂散 光的影响,该实验请在较黑暗的环境中进行。)
 - 打开恒流电源和计算机。
- 将 CMOS 相机和镜头放在导轨大约 520 mm 处,松开锁紧螺钉,调节杆的高度,并 微调升降调节架,确保 CMOS 相机和汞灯窗口处于同一高度。
- 打开塞曼软件,点击连接相机,选择菜单'please select video source'。而后点击'start'按钮,此时,视频窗口将出现。调节镜头的光阑和后焦(如图 15 所示),并调节调整架和选择镜头和 CMOS 相机,使得汞灯光斑清晰的处于在视频窗口中心位置。



图14

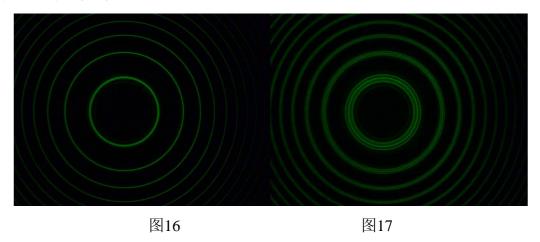


图15

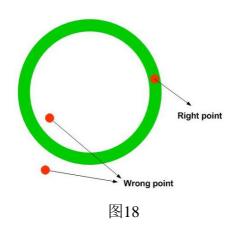
• 将聚光透镜和偏振器系统放在导轨 150mm 处位置(这个位置不是固定,以获得清晰的图像为准),调节杆和升降调节架,确保汞灯光斑在视频窗口中心。**注意:我们观测**

的是π分量,请将偏振器置于90°位置。

• 将干涉滤光器和法布里泊罗标准具系统置于CMOS相机和偏振器之间的位置,使得标准具尽可能靠近相机镜头,但不能碰撞(避免杂散光),此时视频窗口会出现干涉圆环,适当调节聚光透镜的位置和相机镜头光阑,使得图像亮度适中,调节装有法布里泊罗标准具的那个精密调整架的 XY 调节旋钮,使得干涉圆环处于视频窗口中心,调节相机镜头后焦,获得清晰干涉头像,如图 16 所示。

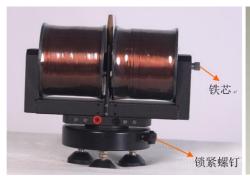


- 增大输入电磁线圈的电流,一般大于 4A 即可看到分裂圆环,5A 实验效果较佳,如果此时干涉圆环有部分分裂,部分模糊,微调法布里泊罗标准具的三颗调节螺钉,获得如图 17 所示的清晰图像。
 - 点击 "interception button" 并保存。.
- 点击 "stopping video" 按钮,并且点击 "select graphic processing" 按钮,然后点击 "open the saved picture"。
 - 利用三点画圆法,从里到外依次画出 9 个圆。注意:正确的选点如图 18 所示。
- 画好 9 个圆后,点击"the modification"按钮,在 the date fence 一栏中会出现这些圆心和直径的数据,这些数据都是指像素。
- 点击在 the data fence 最下面的"compute"按钮,会出现要求输入磁感应强度的对话框。此时取出笔型汞灯,用特斯拉计测量电磁线圈中心处的磁场大小,并输入,点击确定,即可计算出 e/m 的值。
- 注意:测量的磁场应为干涉条纹分裂时候的磁场,即:两者的电流大小应一致,何时测量磁场大小由实验者自行把握
 - 记录数据保存图像,关闭电源整理实验仪器。



2. 平行于磁场方向 (选做)

• 松开锁紧螺钉,取出铁芯,确保汞灯光线从该孔穿出,旋转电磁线圈,使得磁场方向平行于导轨如图 19 和图 20 所示。



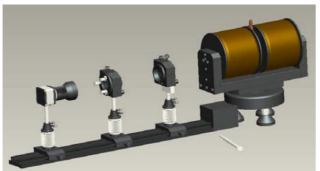


图 19

- 如实验1调整光路。
- 当整套装置调整完毕,可以观查到如图 21 所示现象,此时旋转偏振器,没有任何 影响,说明此时的光线为圆偏正。

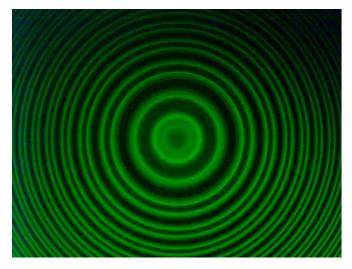


图21

五、实验结果与数据处理

- 1. 实验数据;
- 2. 实验图像;
- 3. 误差分数。